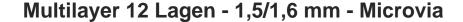




## Lagenaufbau

Ebe	ne		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Тур
		A B	Cu+galv.Cu		18+25	
1			Prepreg	0.048		106
			Prepreg	0.048		106
			Cu	0.40	35	
2	Karan		Tr-Lam Cu	0.10	35	
3			Prepreg	0.048		106
			Prepreg	0.048		106
4			Cu	0.10	35	
4			Tr-Lam Cu	0.10	35	
5			Prepreg	0.048		106
			Prepreg	0.048		106
			Cu	0.40	35	
6			Tr-Lam Cu	0.10	35	
7			Prepreg	0.048		106
			Prepreg	0.048		106
			Cu	0.10	35	
8	Value of the last		Tr-Lam Cu	0.10	35	
9			Prepreg	0.048		106
			Prepreg	0.048		106
40			Cu	0.40	35	
10			Tr-Lam Cu	0.10	35	
11			Prepreg	0.048		106
			Prepreg	0.048		106
12		T <sub>B</sub>	Cu+galv.Cu		18+25	

Presslingsdicke *	1,40	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstoppmaske *	1,51	+/- 10%





## Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- \* Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

## **Designrules zum Lagenaufbau**

Doolgin aloo Lam Lago	naarbaa						
Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm					
(Vido)	Viapad-Ø	≥ 500 µm					
Lasersacklöcher [B] (blind Vias)	End-Ø	≥ 100 µm					
(Silita Vias)	Viapad-Ø	≥ 350 µm					
Leiterbild Außenlagen							
	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm ≥ 100 µm					
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥100 µm ≥120 µm					
Leiterbild Innenlagen							
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm ≥ 80 µm					
Standard	Leiterbreite bei 35 μm Grundkupfer Leiterabstand bei 35 μm Grundkupfer	≥85 µm ≥ 100 µm					